**Лабораторная работа 6.8**

**Вариант №2**

**Изучение температурной зависимости электропроводности полупроводников**

**1. Цель работы**

Изучить зависимость электропроводности полупроводникового образца от температуры. Определить ширину запрещенной зоны

**2. Теоретическое введение**

Электропроводность S:\Image6.gif материалов определяется выражением:

S:\Image7.gif    (1)

где q+ и q- - соответственно величина заряда положительных и отрицательных носителей электрического заряда, n+ и n- - концентрация соответственно положительных и отрицательных носителей заряда, µ+ и µ- - подвижности положительных и отрицательных носителей заряда.

В нашей задаче исследуется собственная электропроводность полупроводника. Поэтому положительными носителями заряда являются дырки, а отрицательными- электроны. Следовательно,

|q+| = |q-| = e

и, поскольку полупроводник собственный, то n+ = n- = n

Тогда S:\Image8.gif   (2)

Здесь µn и µp- подвижность электронов проводимости и дырок, соответственно.

Строго говоря, от температуры зависят и концентрация, и подвижности носителей заряда. Однако, во многих случаях в узком диапазоне температур зависимостью подвижностей от температуры можно пренебречь и считать подвижности постоянными, не зависящими от температуры. В данной работе рассматривается именно этот случай.

Зависимость концентрации собственных носителей от температуры описывается экспонентой:

S:\Image9.gif

Здесь *Eg -* ширина запрещенной зоны, *k*- постоянная Больцмана, *T-* температура образца, *n0-* концентрация носителей при высоких температурах.

Отсюда

S:\Image10.gif

Обозначим ***n0 e(µn+µp)=*** ***S:\Image11.gif*** и условно назовем это электропроводностью образца при бесконечно большой температуре. В результате получим выражение для электропроводности образца:

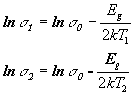
S:\Image12.gif

Таким образом, зависимость электропроводности собственного полупроводника от температуры является экспоненциальной. Уравнение (5) поддается экспериментальной проверке и позволяет определить ширину запрещенной зоны полупроводника ***Eg*** . Именно это и является целью данной лабораторной работы.

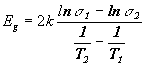
Прологарифмируем формулу (5). Получим:

S:\Image13.gif

Отсюда следует, что график зависимости S:\Image14.gifот S:\Image15.gifпредставляет собой прямую линию, что легко проверить практически. Для вычисления ширины запрещенной зоны *Eg* поступим следующим образом. Построим прямую (6). В уравнении (6) имеем два неизвестных: ширину запрещенной зоны *Eg* и логарифм электропроводности при бесконечно большой температуре *ln* 0. Возьмем на прямой (6) две произвольные точки. Уравнение (6) для этих точек запишется как



Решив эту систему относительно ***Eg*** получим:



Формула является рабочей для вычисления ширины запрещенной зоны полупроводника.

В данной работе полупроводниковый образец выполнен в виде параллелепипеда, имеющего длину ***l***, ширину ***a*** и высоту ***b*.** Для вычисления электропроводности образца воспользуемся законом Ома. Электрическое сопротивление образца по закону Ома равно

S:\Image18.gif

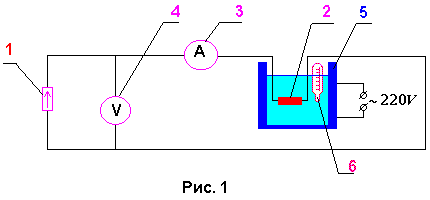
где *U-* электрическое напряжение на образце, *I-* сила тока через образец. Приняв во внимание геометрию образца и связь электропроводности и удельного сопротивления S:\Image19.gifнайдем выражение для электропроводности полупроводникового образца

S:\Image21.gif

где ***S=ab****-* площадь поперечного сечения образца.

**3. Описание лабораторной установки**

Схема лабораторной установки приведена на рис.1.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила тока источника (1) не зависит от сопротивления нагрузки. Нагрузкой источника является образец (2). Сила тока, протекающего через образец, регистрируется миллиамперметром (3), а напряжение на образце измеряется при помощи вольтметра (4). Образец наклеен на электроизолирующую теплопроводную пластину и помещен в печь (5) с маслом. Туда же помещен термометр (6) для измерения температуры образца.    **4. Задание**  Выполняется по вариантам.   |  |  | | --- | --- | | Вариант | Сила тока, мА | | 1 | 3 | | 2 | 3,8 | | 3 | 4,6 | | 4 | 5,4 | | 5 | 6,2 | | 6 | 7 | | 7 | 7,8 | | 8 | 8,6 | | 9 | 9,4 | | 10 | 10 |  1. Установить силу тока через образец в соответствии с вариантом. Записать силу тока в отчет по лабораторной работе. 2. Изменяйте температуру образца от 250С до 800С через 50С, каждый раз записывая напряжение на образце. Полученные данные занесите в таблицу в отчете по лабораторной работе. 3. Вычислить по формуле (10) электропроводности образца при всех температурах. Прологарифмировать полученные значения электропроводности. 4. Вычислите абсолютные температуры образца Т= t+273, К. Все данные занесите в таблицу измерений. 5. Построить график зависимости ***ln*** от 1 Т. 6. На графике выбрать две точки в диапазоне температур от 400С до 800С. Определить для этих точек по графику величины ***ln*** и 1  и вычислить по формуле (8) ширину запрещенной зоны полупроводника.   **5. Контрольные вопросы**   1. Вывести формулу для собственной электропроводности полупроводника. 2. Почему для проверки температурной зависимости электропроводности полупроводников строится график зависимости ***ln*** от    **.**? 3. Вывести формулу для вычисления ширины запрещенной зоны полупроводника.   **6. Литература**   1. Савельев И.В. Курс общей физики.- М.: Наука, 1979,- т.3,§ 57,58,59. 2. Айзенцон А.Е. Курс физики.- М.: Высшая школа, 1996.- Гл.19 § 19.3 |